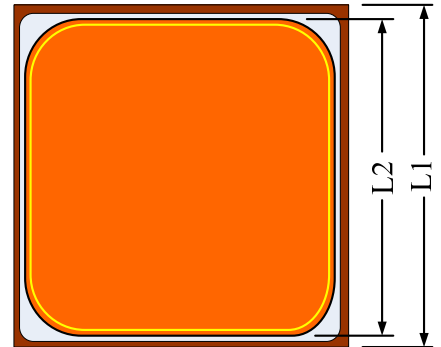


1N5820-50/1N5822-50/SR360-50 肖特基二极管芯片

简述:

- ✚ 本肖特基二极管芯片采用硅外延工艺制造;
- ✚ 损耗功率小, 效率高;
- ✚ 采用瞬态反应能力的保护环结构;
- ✚ 具有较高 ESD 抗静电击穿能力;
- ✚ 具有高抗浪涌电流能力;
- ✚ 可广泛应用于开关电源、整流电路及极性保护电路等各类电子电路中;
- ✚ 芯片图形尺寸: $1270 \times 1270 \mu\text{m}$;
- ✚ 芯片厚度: $280 \pm 10 \mu\text{m}$;
- ✚ 可分别适用于轴向封装、表面贴封装及金丝和硅铝丝压焊封装。



芯片尺寸示意图

 芯片尺寸 L1: $1200 \mu\text{m}$;

 压点尺寸 L2: $1270 \mu\text{m}$;

极限参数:

| 参数名称 | 符号 | 额定值 | | | 单位 |
|------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|
| | | 1N5820-50 | 1N5822-50 | SR360-50 | |
| 最大直流阻断电压 | V_{RRM} | 20 | 40 | 60 | Volts |
| 正向平均整流电流 | I_{FAV} | 3 | | | Amps |
| 正向峰值浪涌电流 @ 8.3ms | I_{FSM} | 50 | | | Amps |
| 最高工作结温 | T_J | 125 | | | $^{\circ}\text{C}$ |
| 芯片存储温度 | T_{STG} | -40 ~ +125 | | | $^{\circ}\text{C}$ |
| 最低抗静电电压 | ESD | 8000 | | | Volts |

电参数及规格 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$):

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 额定值 | | | 单位 |
|---------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 1N5820 | 1N5822 | SR360 | |
| 反向击穿电压 | V_{BR} | $I_R=100 \mu\text{A}$ | ≥ 25 | ≥ 45 | ≥ 65 | Volts |
| 正向压降 | V_F | $I_F=3\text{A}$ | ≤ 0.48 | ≤ 0.58 | ≤ 0.63 | Volts |
| 反向漏电流 | I_R | | $I_R \leq 50 @ V_R=25\text{V}$ | $I_R \leq 50 @ V_R=45\text{V}$ | $I_R \leq 50 @ V_R=65\text{V}$ | μAmps |
| 特性曲线 $\Delta V_R \leq$ | ΔV_R | $I_{R1}=50 \mu\text{A}$ $I_{R2}=500 \mu\text{A}$ | ≤ 4 | | | Volts |